

ABSTRACT

検査装置及びその検査装置を用いた半導体デバイスの製造方法。検査装置は、ウエハ等の試料の欠陥検査、線幅測定、表面電位測定等を行うため使用される。検査装置において、一次光学系から複数の荷電粒子が試料に入射され、試料から
5 放出される二次荷電粒子が一次光学系から分離され、二次光学系を介し検出器へ導かれる。荷電粒子の照射は、試料を移動しながら行われる。荷電粒子照射点は、試料の移動方向にN行、これと直角方向にM列に配置される。荷電粒子照射点の各行が、順次、試料移動方向と直角方向に一定量ずつずらされる。